V

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ การศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์ม โปรงใส โลหะออกไซค์

ชื่อผู้เชียน

นายวิเศษ จูลพันธุ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการสอนพิสิกส์

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนช์

ยศ.จีระพงษ์ ตันตระกูล

ประชานกรรมการ

รศ.คร.หวี

ทันมศิริ

กรรมก**าร**

อ.คร.กิงแกว

ศิริวิทยากร

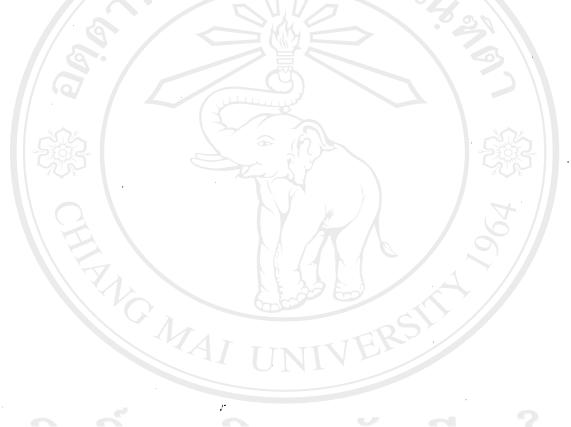
บรรมบาร

บหลักยอ

ที่ล์มคีบุกออกไซค์ (sno₂) เตรียมชื้นโดยการสเปรยสารละลายของ
sncl₄ ความเข้มข้น 2.0 โมลาร์ และ sbcl₃ ซึ่งใช้เป็นตัวโดปในปริมาณตาง ๆ กัน
โดยมีน้ำ Ethanol และ HCl เป็นตัวทำละลาย ลงบนแผนกระจกรองรับที่มีอุณหภูมิ
550°ช พบวาหืล่มมีคา Resistivity ทำสุดเทากับ 1x10⁻³ a.cm. เมื่อโดปด้วย
sb เทากับ 1.3 mole % และมีเปอร์เซนต์การทะลุผานของแสง Visible light
อยูระหวาง 50% - 70% เมื่อหืล้มมีความหนาเทากับ 1x10⁻⁴ cm.

พื่อมแคกเมี่ยมออกไซค์-กีบุกออกไซค์ (Cdo-sno₂) เตรียมชื้นโดยการ สเปรย์สารละลายผสมระหวาง CdCl₂ และ sncl₄ ที่มีความเข้มข้นอยางละ 0.5 โมลาร์ และ sbcl₃ ซึ่งใช้เป็นตัวโคปในปริมาณตาง ๆ กัน โดยมีน้ำ, Ethanol และ HCl เป็นตัวทำละลาย ลงบนแผนกระจกรองรับที่มีอุณหภูมิ 550 ซ พบวาหีล์ม Cdo-sno₂ ที่เครียมโดยใช้อัตราสวน Cdcl₂:sncl₄ = 1:2 mole มีคา Resistivity ต่าสุดเทากับ 1.7x10⁻³ a.cm. เมื่อโดปด้วย sb เทากับ 2.0 mole % และมีเปอร์เซนต์การทะลุผานของแสง Visible light อยูระหวาง 60% - 80 % เมื่อหีล์มมีความหนาเทากับ 1x10⁻⁴ cm.

พื่ลมชิงค์ออกไซค์ (zno) เครียมชื้นโดยการสเปรย์สารละลายซอง zn(CH₃COO)₂ ที่มีความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ โดยมีน้ำและ Ethanol เป็นตัวทำ ละลาย ลงบนแผนกระจกรองรับที่มีอุณหภูมิ 450°ซ ฟิล์ม zno ที่ได้มีคา Resistivity เทากับ 8.6 ฉ.cm. และเปอร์เซนต์การทะลุผานซองแสง visible light อยูระหวาง 40% - 75% เมื่อฟิล์มมีความหนา 1.1×10⁻⁴ cm.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved Research Title A Study on Electrical Conducting Properties

of Metal Oxide Transparent Films

Author

Mr. Wised Joonlaphun

M.S.

Teaching Physics.

Examining Committee

Assist.Prof. Jerapong Tantragoon Chairman

Assoc.Prof. Dr.Tawee Tunkasiri Member

Lecturer Dr.Kingkeo Siriwitayakorn Member

Abstract

Films of Tin Oxide (SnO₂) were prepared by spraying the solution of Tin tetrachloride (2.0 molar concentration) and Antimony trichloride (SbCl₃), which was used as the doping substance, on hot substrates (550°C glass slides). The solvent used was a mixture of pure water, ethanol and hydrochloric acid. The amount of SbCl₃ in the solution was varied for each sample to investigate the effect of different doping. The results show that the sample with 1.3 mole percent of doped SbCl₃ gave the lowest resistivity of 1.0x10⁻³ Q.cm. while allowing 50% - 70% transmitted visible light and the film was 1x10⁻⁴ cm. thick

Films of Cadmium Oxide and Tin Oxide (CdO-SnO $_2$) were also prepared in the same manner using solution of Cadmium chloride (CdCl $_2$) and Tin tetrachloride (SnCl $_4$). The lowest

resistivity obtained in this case was 1.7×10^{-3} Q.cm. while allowing 60% - 80% transmission of visible light. The sample giving lowest resistivity was prepared from the solution which had the ratio of $CdCl_2:SnCl_4 = 1:2$ mole and 2.0 mole percent of Sb. The film thickness was 1×10^{-4} cm.

Films of Zinc Oxide (ZnO) were also obtained using solution of Zinc acetate (0.2 molar concentration). The hot substrates in this case were 450°C - glass slides. The lowest resistivity found was $8.6~\Omega_{\circ}\text{cm}_{\circ}$ with 40% - 75% transmitted visible light while the film thickness was 1.1×10^{-4} cm.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved